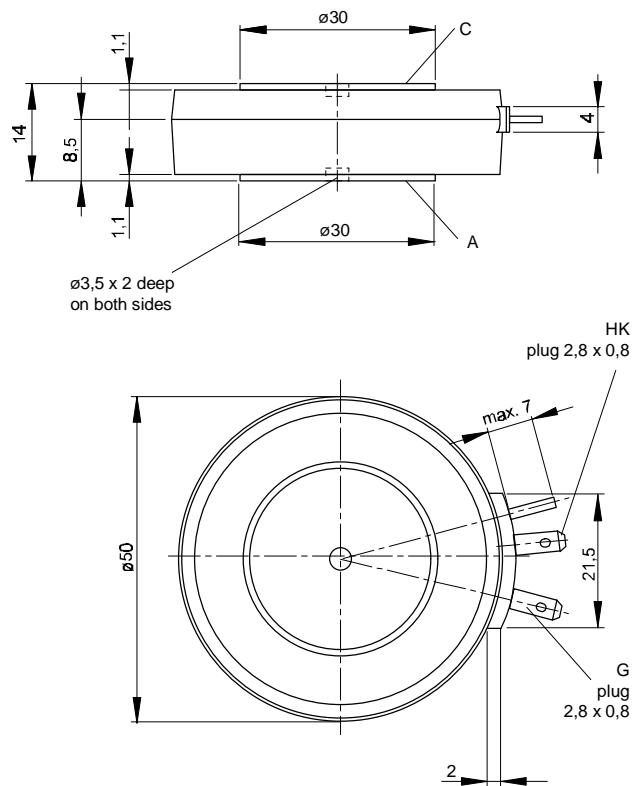


European Power-
Semiconductor and
Electronics Company

Marketing Information T 268 N



T 268 N

Elektrische Eigenschaften

Höchstzulässige Werte

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenstromspannung
Vorwärts-Stoßspitzenstromspannung

Rückwärts-Stoßspitzenstromspannung

Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

Stoßstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Electrical properties

Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and reverse voltage
non-repetitive peak forward off-state voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current

average on-state current

surge current

$I^2 t$ -value

critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$

$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$

$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$

$t_c = 85^\circ\text{C}$

$t_c = 82^\circ\text{C}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\ \text{ms}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\ \text{ms}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\ \text{ms}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\ \text{ms}$

DIN IEC 747-6, $f = 50\ \text{Hz}$,

$v_L = 10\ \text{V}, i_{GM} = 1\ \text{A}, di_G/dt = 1\ \text{A}/\mu\text{s}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,67\ V_{DRM}$

5.Kennbuchstabe/5th letter F

V_{DRM}, V_{RRM}

2000 2200 2400 V

2600

V_{DSM}

2000 2200 2400 V

2600

V_{RSM}

2100 2300 2500 V

2700

I_{TRMSM}

440 A

I_{TAVM}

268 A

280 A

I_{TSM}

4200 A

3700 A

$I^2 t$

88200 A^2s

68450 A^2s

60 $\text{A}/\mu\text{s}$

$(di_T/dt)_{cr}$

$(dv_D/dt)_{cr}$

1000 $\text{V}/\mu\text{s}$

Charakteristische Werte

Durchlaßspannung

Schleusenspannung

Ersatzwiderstand

Zündstrom

Zündspannung

Nicht zündender Steuerstrom

Nicht zündende Steuerspannung

Haltestrom

Einraststrom

Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom

Zündverzug

Freiwerdezeit

Characteristic values

on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current

gate trigger voltage

gate non-trigger current

gate non-trigger voltage

holding current

latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 800\ \text{A}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\ \text{V}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\ \text{V}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 6\ \text{V}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,5\ V_{DRM}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,5\ V_{DRM}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\ \text{V}, R_A = 5\ \Omega$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\ \text{V}, R_{GK} \geq 10\ \Omega$

$i_{GM} = 1\ \text{A}, di_G/dt = 1\ \text{A}/\mu\text{s}, t_g = 20\ \mu\text{s}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}$

DIN IEC 747-6, $t_{vj}=25^\circ\text{C}, i_{GM}=1\text{A}, di_G/dt=1\text{A}/\mu\text{s}$

$t_{vj}=t_{vj\ max}, i_{TM}=i_{TAVM}, v_{RM}=100\ \text{V}, v_{DM}=0,67\ t_q$

$V_{DRM}, dv_D/dt=20\ \text{V}/\mu\text{s}, -di_T/dt=10\ \text{A}/\mu\text{s}, 4\ \text{Kennbuchstabe/4th letter O}$

v_T

max. 3,05 V

$V_{T(TO)}$

1,20 V

r_T

2,25 $\text{m}\Omega$

I_{GT}

max. 200 mA

V_{GT}

max. 2 V

I_{GD}

max. 10 mA

max. 5 mA

V_{GD}

max. 0,25 V

I_H

max. 300 mA

I_L

max. 1200 mA

i_D, i_R

max. 70 mA

t_{gd}

max. 4,0 μs

typ. 200 μs

Thermische Eigenschaften

Innerer Wärmewiderstand

Thermal properties

thermal resistance, junction to case

Kühlfläche/cooling surface

R_{thJC}

max. 0,056 $^\circ\text{C}/\text{W}$

beidseitig/two-sided, $\Theta = 180^\circ \sin$

max. 0,050 $^\circ\text{C}/\text{W}$

beidseitig/two-sided, DC

max. 0,091 $^\circ\text{C}/\text{W}$

Anode/anode, $\Theta = 180^\circ \sin$

max. 0,085 $^\circ\text{C}/\text{W}$

Anode/anode, DC

max. 0,126 $^\circ\text{C}/\text{W}$

Kathode/cathode, $\Theta = 180^\circ \sin$

max. 0,120 $^\circ\text{C}/\text{W}$

Kathode/cathode, DC

Übergangs-Wärmewiderstand

Kühlfläche/cooling surface

R_{thCK}

max. 0,01 $^\circ\text{C}/\text{W}$

beidseitig/two-sided

max. 0,02 $^\circ\text{C}/\text{W}$

einseitig/single-sided

Höchstzul. Sperrschichttemperatur

$t_{vj\ max}$

125 $^\circ\text{C}$

Betriebstemperatur

$t_{c\ op}$

-40...+125 $^\circ\text{C}$

Lagertemperatur

t_{stg}

-40...+150 $^\circ\text{C}$

Mechanische Eigenschaften

Mechanical properties

Si-Elemente mit Druckkontakt

Si-pellet with pressure contact

Anpreßkraft

clamping force

F

5...10 kN

Gewicht

weight

G

typ. 100 g

Kriechstrecke

creepage distance

17 mm

Feuchtekategorie

humidity classification

C

Schwingfestigkeit

vibration resistance

50 m/s²

Gehäuse

case

Titelseite / Front page